








	<h2>SIA436DJ-T1-GE3</h2>
	<p>Hersteller-Teilenummer: SIA436DJ-T1-GE3</p> <p>Hersteller / Marke: Vishay / Siliconix</p> <p>Teil der Beschreibung: MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L</p> <p>Datenblätter:  SIA436DJ-T1-GE3.pdf</p> <p>RoHs Status: Bleifrei / RoHS-konform</p> <p>Lagerzustand: New original, 3099 pcs Stock Available.</p> <p>Liefern von: Hong Kong</p> <p>Versandweg: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	SIA436DJ-T1-GE3
Hersteller	Vishay / Siliconix
Beschreibung	MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Transistoren-FETs ,
Teilstatus	3099 pcs Stock
Serie	TrenchFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6
Supplier Device-Gehäuse	PowerPAK® SC-70-6 Single
Verlustleistung (max)	3.5W (Ta), 19W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	8V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	12A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	9.4 mOhm @ 15.7A, 4.5V
VGS (th) (Max) @ Id	800mV @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	25.2nC @ 5V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1508pF @ 4V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	1.2V, 4.5V
Vgs (Max)	±5V
Verpackung	Tape & Reel (TR)

SIA436DJ-T1-GE3 ist neu im Original, Suche SIA436DJ-T1-GE3 Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie SIA436DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix mit Garantie und Vertrauen. Anfrage SIA436DJ-T1-GE3: Info@Y-IC.com

Sie können auch interessiert sein:

 <p>SIA436DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 8V 12A SC70-6L</p>	 <p>SIA437DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 29.7A SC70-6</p>	 <p>SIA438EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET N-CH 20V 6A PPAK SC70-6L</p>	 <p>SIA437DJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 29.7A SC70-6</p>
 <p>SIA433EDJ VISHAY SIA433EDJ VISHAY</p>	 <p>SIA433EDJ-T1-GE3 Electro-Films (EFI) / Vishay MOSFET P-CH 20V 12A SC-70-6</p>	 <p>SIA432DJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET N-CH 30V 12A SC70-6</p>	 <p>SIA433EDJ-T1-GE3 Vishay / Siliconix MOSFET P-CH 20V 12A SC-70-6</p>

heiße Teile

Mehr

SIA419DJ	SIA419DJ-T1-GE3	SIA419DJ-T1-GE3	SIA421DJ-T1-GE3	SIA421DJ-T1-GE3
SIA425EDJ-T1-GE3	SIA425EDJ-T1-GE3	SIA426DJ-T1-GE3	SIA426DJ-T1-GE3	SIA427DJ-T1-GE3
SIA427DJ-T1-GE3	SIA429DJ-T1-GE3	SIA429DJ-T1-GE3	SIA430DJ-T1-GE3	SIA430DJ-T1-GE3
SIA431DJ	SIA431DJ-T1	SIA431DJ-T1-GE3	SIA431DJ-T1-GE3	SIA432DJ-T1-GE3
SIA432DJ-T1-GE3	SIA433EDJ	SIA433EDJ-T1-GE3	SIA433EDJ-T1-GE3	SIA436DJ-T1-GE3
SIA443DJ-T1-GE3	SIA443DJ-T1-GE3	SIA444DJ-T1-GE3	SIA444DJ-T1-GE3	SIA445EDJ-T1-GE3
SIA445EDJ-T1-GE3	SIA447DJ-T1-GE3	SIA447DJ-T1-GE3	SIA448DJ-T1-GE3	SIA448DJ-T1-GE3
SIA449DJ-GE3	SIA450DJ-T1-GE3	SIA450DJ-T1-GE3	SIA4528-100K	SIA4528-330K
SIA4528-470K	SIA453EDJ-T1-GE3	SIA453EDJ-T1-GE3	SIA456DJ-T1-GE3	SIA456DJ-T1-GE3
SIA483DJ-T1-GE3	SIA483DJ-T1-GE3	SIA513DJ-T1-E3	SIA517DJ-T1-GE3	SIA517DJ-T1-GE3

Contact us: Info@Y-IC.com

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited